# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-279591

(43) Date of publication of application: 26.10.1993

(51)Int.CI.

CO9B 67/50 G03G 5/06

(21)Application number: 04-103825

31.03.1992 (22)Date of filing:

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

(72)Inventor: DAIMON KATSUMI

**NUKADA KATSUMI** 

**IMAI AKIRA** 

IIJIMA MASAKAZU

**ISHII TORU** 

# (54) PREPARATION OF NOVEL CRYSTAL OF HYDROXYGALLIUM PHTHALOCYANINE AND ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR MADE USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To prepare novel crystals of hydroxygallium phthalocyanine from which an electrophotographic photoreceptor high in sensitivity, good in durability and excellent in stability can be formed by treating hydroxygallium phthalocyanine with a first solvent, pulverizing it and treating it with a second solvent.

CONSTITUTION: Hydroxygallium phthalocyanine is treated with a first solvent, mechanically pulverized, and then treated with a second solvent to prepare crystals of hydroxygallium phthalocyanine, the X-ray diffraction spectrum of which has strong peaks of diffraction at Bragg angles (20±0.2°) of 7.5°, 9.9°, 12.5°, 16.3°, 18.6°, 25.1° and 28.3°. The first and second solvents may be 'the same or different from each other. Pref. examples of the first and second solvents include amides, esters, and ketones. The phthalocyanine compd., which has heretofore been proposed, is not sufficiently satisfactory in photosensitivity and durability when formed into a photoreceptor. By contrast, the above- mentioned crystals of hydroxygallium phthalocyanine is excellent in photosensitivity and durability.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

19.06.1998

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3166283

[Date of registration]

09.03.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-279591

(43)公開日 平成5年(1993)10月26日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

FΙ

技術表示箇所

C 0 9 B 67/50

Z 7306-4H

371

8305-2H

庁内整理番号

G03G 5/06

審査請求 未請求 請求項の数6(全 11 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平4-103825

平成 4年(1992) 3月31日

(71)出願人 000005496

富士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂三丁目3番5号

(72)発明者 大門 克己

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社竹松事業所内

(72)発明者 額田 克己

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社竹松事業所内

(72)発明者 今井 彰

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ックス株式会社竹松事業所内

(74)代理人 弁理士 渡部 剛

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ヒドロキシガリウムフタロシアニンの新規な結晶の製造方法とその方法で製造された結晶を用い

(57)【要約】

る電子写真感光体

【目的】 ヒドロキシガリウムフタロシアニンの新規な 結晶の製造方法とその方法により製造される結晶を用い た電子写真感光体を提供する。

【構成】 ヒドロキシガリウムフタロシアニンの新規な 結晶は、X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角(2  $\theta\pm0$  . 2° ) % 7. 5° 、 9. 9° 、 12. 5° 、 1 6.3°、18.6°、25.1°および28.3°に 強い回折ピークを有する。この結晶は、ヒドロキシガリ ウムフタロシアニンを、第一の溶剤で処理し、機械的に 粉砕した後、第二の溶剤で処理するか、あるいは、第一 の溶剤で処理するに先立って、予めアシッドペースティ ング処理または機械的粉砕で微粉化し、以後同様に処理 することにより製造される。第一、第二の溶剤として は、アミド類、エステル類またはケトン類が好ましい。 電子写真感光体は、上記方法で製造されたヒドロキシガ リウムフタロシアニン結晶を含有する感光層を導電性支 持体上に被覆したものからなる。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ヒドロキシガリウムフタロシアニンを第一の溶剤で処理し、次いで、機械的に粉砕した後、第二の溶剤で処理することを特徴とする、X線回折スペクトルにおけるブラッグ角( $2\theta\pm0$ .  $2^\circ$ )の7.  $5^\circ$ 、9.  $9^\circ$ 、1 2.  $5^\circ$ 、1 6.  $3^\circ$ 、1 8.  $6^\circ$ 、2 5.  $1^\circ$  および 2 8.  $3^\circ$  に強い回折ピークを有するヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の製造方法。

【請求項2】 第一の溶剤で処理するに先立って、ヒドロキシガリウムフタロシアニンを予めアシッドペースティング処理または機械的粉砕で微粉化することを特徴とする請求項1に記載のヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の製造方法。

【請求項3】 第一の溶剤と第二の溶剤が同じである請 求項1または2に記載のヒドロキシガリウムフタロシア ニン結晶の製造方法。

【請求項4】 第一の溶剤が、アミド類、エステル類およびケトン類の溶剤から選ばれる1種または2種以上である請求項1または2に記載のヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の製造方法。

【請求項5】 第二の溶剤が、アミド類、エステル類およびケトン類の溶剤から選ばれる1種または2種以上である請求項1または2に記載のヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の製造方法。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載の方法で 製造されたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶を含 有する感光層を導電性支持体上に被覆してなる電子写真 感光体。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光導電材料として有用なヒドロキシガリウムフタロシアニンの新規な結晶の製造方法およびその方法で製造された結晶を用いる電子写真感光体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】フタロシアニンは、塗料、印刷インキ、触媒あるいは電子材料として有用な材料であり、特に近年は電子写真感光体用材料、光記録用材料および光電変換材料として広範に検討がなされている。電子写真感光体についてみると、近年、従来提案された有機光導電材料の感光波長域を近赤外線の半導体レーザーの波長(780~830 nm)にまで伸ばし、レーザープリンター等のデジタル記録用感光体として使用することの要求が高まっており、この観点から、スクエアリウム化合物(特開昭49-105536号および同58-21416号公報)、トリフェニルアミン系トリスアゾ化合物(特開昭48-34189号および同57-148745号公報)等が、半導体レーザー用光導電材料として提案されている。

【0003】半導体レーザー用感光材料として有機光導電材料を使用する場合は、まず、感光波長域が長波長まで伸びていること、次に、形成される感光体の感度、耐久性がよいことなどが要求される。前記の有機光導電材料はこれらの諸条件を十分に満足するものではない。これらの欠点を克服するために、前記の有機光導電材料について、結晶型と電子写真特性の関係が検討されており、特にフタロシアニン化合物については多くの報告がなされている。

【0004】一般に、フタロシアニン化合物は、製造方 法、処理方法の違いにより、多数の結晶型を示し、この 結晶型の違いはフタロシアニン化合物の光電変換特性に 大きな影響を及ぼすことが知られている。フタロシアニ ン化合物の結晶型については、例えば、銅フタロシアニ ンについてみると、安定系のβ型以外に、 $\alpha$ 、 $\pi$ 、x、 ho 、 $\gamma$  、 $\delta$  等の結晶型が知られており、これらの結晶型 は、機械的歪力、硫酸処理、有機溶剤処理および熱処理 等により、相互に転移が可能であることが知られている (例えば米国特許第2, 770, 629号、同第3, 1 60,635号、同第3,357,989号および同第 3,708,292号明細書)。また、特開昭50-3 8543号公報等には、銅フタロシアニンの結晶型の違 いと電子写真感度との関係について記載されており、こ のように、フタロシアニン化合物については、製造方 法、処理方法の違いが電子写真特性に大きく影響するこ とが知られている。

【0005】一般に、フタロシアニンの結晶はアシッド ペースティングまたは機械的に粉砕したフタロシアニン を適当な溶剤で処理し、目的の結晶を得るものであった が、電子写真特性を向上させるため、特殊な処理を行っ ている例もある。例えば、特開昭61-171771号 公報には、Nーメチルピロリドン処理によるフタロシア ニンの精製について記載されており、精製により電子写 真特性が向上することが記載されている。また、不純物 の影響についても種々の報告があり、電子写真学会誌、 第28巻、第3号、269 (1989) には、同じ構 造、同じ結晶型のものであっても、昇華精製を繰り返す ことにより、その電子写真特性は大きくことなることが 報告されている。また、ヒドロキシガリウムフタロシア ニンの結晶型と電子写真特性の関係についてみると、特 開平1-221459号公報にアシッドペースティング 法のみによって得られた結晶について記載されている。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のヒドロキシガリウムフタロシアニンの結晶型に限らず、従来提案されているフタロシアニン化合物は、感光材料として使用した場合の光感度と耐久性の点で未だ十分満足できるものではない。また、上記した製造方法、処理方法により製造したフタロシアニン化合物であっても、感光材料として使用した場合の光感度と耐久性の点で未

だ十分満足できるものではない。したがって、光導電材料としてのフタロシアニン化合物の特長を活かしつつ、光感度と耐久性が改善された新たなフタロシアニン結晶の開発が望まれていた。本発明は、従来の技術における上述のような問題点に鑑みてなされたものである。すなわち、本発明の目的は、光感度と耐久性に優れたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の製造方法およびその結晶を含有する電子写真感光体を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、鋭意研究を重ねた結果、合成によって得られるヒドロキシガリウムフタロシアニンに溶剤処理と機械的粉砕を組み合わせた特定の処理を施すことによって、光導電材料として高い感度と良好な耐久性を有する新規な結晶が得られ、この新規な結晶を感光層に含有する電子写真感光体が優れた電子写真特性を有することを見出して、本発明を完成するに至った。

【0008】すなわち、本発明は、ヒドロキシガリウムフタロシアニンを第一の溶剤で処理し、次いで、機械的に粉砕した後、第二の溶剤で処理して、X線回折スペクトルにおけるブラッグ角(20±0.2°)の7.5°、9.9°、12.5°、16.3°、18.6°、25.1°および28.3°に強い回折ピークを有するヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の製造方法にあり、この製造方法では、第一の溶剤で処理するに先立って、ヒドロキシガリウムフタロシアニンを予めアシッドペースティング処理または機械的粉砕で微粉化してよい。上記の第一、第二の溶剤としては、アミド類によびケトン類がら選ばれる1種または2種の溶剤が好ましい。本発明は、また、上記の方法で製造されたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶を含まで、2000円に表現である。

【0009】以下、本発明を詳述する。原料として用い るヒドロキシガリウムフタロシアニンは、例えば、公知 の方法で合成されるクロロガリウムフタロシアニンを酸 もしくはアルカリ性溶液中で加水分解するかまたはアシ ッドペースティングを行って合成することができる。本 発明は、上記のような公知の方法で合成されるヒドロキ シガリウムフタロシアニンに一連の処理工程、具体的に は、第一の溶剤での処理-機械的粉砕-第二の溶剤での 処理を施すことによって、X線回折スペクトルにおい て、ブラッグ角(2 θ ± 0. 2°) が 7. 5°、 9. 9 ° 、12.5°、16.3°、18.6°、25.1° および28.3°に強い回折ピークを有するヒドロキシ ガリウムフタロシアニン結晶が製造される。また、一連 の処理工程に先立って、予め非晶化または機械的な粉砕 処理を原料のヒドロキシガリウムフタロシアニンに施し てもよい。この非晶化または機械的な粉砕処理には、ア シッドペースティング処理やボールミル、乳鉢、サンド ミル、ニーダー、アトライター等を用いる粉砕処理があ げられる。

【0010】一連の処理工程において、第一の溶剤および第二の溶剤は、同一または異なっていてもよく、好ましくは、アミド類、エステル類、ケトン類等が使用される。アミド類としては、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン等が例示され、エステル類としては、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、酢酸iso-アミル等が例示され、ケトン類としては、アセトン、メチルエチルケトン、メチルiso-ブチルケトン等が例示される。第一、第二の溶剤は、これらの溶剤を2種以上混合した混合系または水とこれらの溶剤との混合系などであってもよい。

【0011】第一、第二の溶剤で処理するに際して、ヒ ドロキシガリウムフタロシアニン 1 部に対する溶剤の使 用量は1~200部、好ましくは10~100部の範囲 が適当であり、処理温度は0~200℃、好ましくは室 温~150℃の範囲である。また、各溶剤の処理は適当 な容器中で放置または撹拌しながら行ってもよい。さら には、ボールミル、乳鉢、サンドミル、ニーダー、アト ライター等により湿式粉砕しながら第一、第二の溶剤で 処理を行ってもよく、粉砕の際に、食塩、ぼう硝等の磨 砕助剤を用いてもよい。このような第一、第二の溶剤で 処理することにより、結晶性が良好で、粒径の整ったヒ ドロキシガリウムフタロシアニン結晶が得られる。な お、アミド類、エステル類、ケトン類等を用いて上記の 第一、第二の溶剤で処理を行っても、洗浄溶剤として低 沸点アルコール、例えばメタノールを用いると、ヒドロ キシガリウムフタロシアニン結晶が一部結晶転移し、所 望の結晶が純粋に得られないこともあり得る。しかしな がら、アミド類、エステル類、ケトン類等を用いて洗浄 すれば、結晶転位は起こらない。

【0012】上記一連の工程において、第一の溶剤で処理した後にヒドロキシガリウムフタロシアニンを機械的に粉砕する手段としては、ボールミル、乳鉢、サンドミル、ニーダー、アトライター等が用いられる。この機械的な粉砕では、ヒドロキシガリウムフタロシアニンが十分に微粉化されるまで行うのが望ましい。

【0013】従来法ではミクロ的に欠陥の多いヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶が製造されていたが、本発明の製造方法によれば、欠陥の少ない結晶が得られ、この結晶を電子写真感光体の光導電材料として用いると、優れた電子写真特性を有する電子写真感光体を作製することができる。すなわち、以上のような一連の工程により、ヒドロキシガリウムフタロシアニンの結晶変換が行われ、X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角(2 $\theta$ ±0.2°)が7.5°、9.9°、12.5°、16.3°、18.6°、25.1°および28.3°に強い回折ピークを有し、高い感度と耐久性を有するヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶が製造され

る。

【0014】次に、上記の方法で製造されるヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶を用いた電子写真感光体について説明する。本発明の電子写真感光体は、感光層が単層構造のものであってもあるいは電荷発生層と電荷輸送層とに機能分離された積層構造のものであってもよい。図1ないし図4は、本発明の電子写真感光体を模式的に示す断面図である。図1において、電荷発生層1およびその上に積層された電荷輸送層2からなる感光層が導電性支持体3上に被覆されている。図2においては、電荷発生層1と導電性支持体3の間に下引層4が介在しており、また、図3においては、感光層の表面に保護層5が被覆されている。さらに、図4においては、下引層4と保護層5の両者が積層されている。

【0015】図1ないし図4において、電荷発生層1 は、本発明の製造方法により得られるヒドロキシガリウ ムフタロシアニン結晶および結着樹脂から構成される。 使用する結着樹脂は、広範な絶縁性樹脂から選択するこ とができ、また、ポリーNービニルカルバゾール、ポリ ビニルアントラセン、ポリビニルピレン等の有機光導電 性ポリマーから選択することもできる。好ましい結着樹 脂としては、例えば、ポリビニルブチラール樹脂、ポリ アリレート樹脂(ビスフェノールAとフタル酸の重縮合 体等)、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、フ ェノキシ樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ポリ 酢酸ビニル樹脂、アクリル樹脂、ポリアクリルアミド樹 脂、ポリビニルピリジン樹脂、セルロース系樹脂、ポリ ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、カゼイン、ポリビニルア ルコール樹脂、ポリビニルピロリドン樹脂等の絶縁性樹 脂をあげることができる。しかし、これらの絶縁性樹脂 あるいは有機光導電性ポリマーに限定されるものではな い。また、これらの結着樹脂は単独または2種以上混合 して用いることができる。

【0016】結着樹脂を溶解する溶媒としては、下引層 4を溶解しないものから選択するのが好ましい。 具体的には、メタノール、エタノール、ロープロパノール、ローブタノール、ベンジルアルコール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、酢酸メチル、酢酸ローブチル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、塩化メチレン、クロロホルム、クロロベンゼン、トルエン等の通常の有機溶媒を単独または2種以上混合して用いることができる。

【0017】前記ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶と結着樹脂との配合比(重量比)は $10:1\sim1:1$ 0の範囲が好ましい。また、ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶を分散させる方法としては、ボールミル分散法、アトライター分散法、サンドミル分散法等の通常の方法を採用することができる。この際、粒子を0.54 m以下、好ましくは $0.3\mu$ m以下、さらに好ましく

は  $0.15\mu$  m以下の粒子サイズに微細化することが有効である。また、分散によってヒドロキシガリウムフタロシアニンの結晶型が変化しない条件が必要とされるが、本発明者等は上記の分散法のいずれを採用しても分散前と結晶型が変化していないことを確認している。電荷発生層 1 を形成するときに採用する塗布方法としては、ブレードコーティング法、マイヤーバーコーティング法、スプレーコーティング法、浸漬コーティング法、ビードコーティング法、エアーナイフコーティング法、カーテンコーティング法等の通常のコーティング法があげられる。そして、電荷発生層 1 の厚みは、一般的には $0.1\sim5\mu$  m、好ましくは $0.2\sim2.0\mu$  mが適当である。

【0018】本発明の電子写真感光体における電荷輸送 層2は、電荷輸送材料を適当な結着樹脂中に含有させて 形成されている。電荷輸送材料としては、2,5-ビス - (p-ジエチルアミノフェニル) -1, 3, 4-オキ サジアゾール等のオキサジアゾール誘導体、1,3,5 ートリフェニルピラゾリン、1-[ピリジルー(2)] -3-(p -ジエチルアミノスチリル)-5-(p -ジ エチルアミノフェニル) ピラゾリン等のピラゾリン誘導 体、トリフェニルアミン、ジベンジルアニリン等の芳香 ,族第三級モノアミノ化合物、N, N' ージフェニルー N, N' -ビス- (m-トリル) ベンジジン等の芳香族 第三級ジアミノ化合物、3-(p -ジエチルアミノフェ ニル) -5, 6-ジー (p-メトキシフェニル) -1, 2, 4-トリアジン等の1, 2, 4-トリアジン誘導 体、4ージエチルアミノベンズアルデヒド 2,2ージフェ ニルヒドラゾン等のヒドラゾン誘導体、2-フェニルー 4ースチリルキナゾリン等のキナゾリン誘導体、6ーヒ ドロキシー2, 3-ジー(p-メトキシフェニル)ベン ゾフラン等のベンゾフラン誘導体、p-(2,2-ジフ ェニルビニル) −N, N−ジフェニルアニリン等のα− スチルベン誘導体、Journal of Imagi ngScience, 29, 7~10 (1985) に記 載されているエナミン誘導体、N-ビニルカルバゾール 等のポリーNービニルカルバゾールおよびその誘導体、 ポリーγーカルバゾールエチルグルタメートおよびその 誘導体、さらには、ピレン、ポリビニルピレン、ポリビ ニルアントラセン、ポリビニルアクリジン、ポリー9-ビニルフェニルアントラセン、ピレンーホルムアルデヒ ド樹脂、エチルカルバゾールーホルムアルデヒド樹脂等 の公知の電荷輸送材料を用いることができるが、これら に限定されるものではない。また、これらの電荷輸送材 料は単独または2種以上混合して用いることができる。

【0019】電荷輸送層2を形成する結着樹脂としては、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、メタクリル樹脂、アクリル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、スチレンーブタジエン共重合体、塩化ビニリデン

ーアクリロニトリル共重合体、塩化ビニルー酢酸ビニル 共重合体、塩化ビニルー酢酸ビニルー無水マレイン酸共 重合体、シリコン樹脂、シリコンーアルキッド樹脂、フェノールーホルムアルデヒド樹脂、スチレンーアルキッ ド樹脂、ポリーNービニルカルバソール樹脂等の公知の 樹脂を用いることができるが、これらに限定されるもの ではない。また、これらの結着樹脂は単独または2種以 上混合して用いることができる。

【0020】電荷輸送層2は、上記電荷輸送材料と結着 樹脂および溶媒からなる塗布液を電荷発生層1上に塗布 して形成される。塗布液における電荷輸送材料と結着樹 脂との配合比(重量比)は、10:1~1:5が好まし い。溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン等の 芳香族炭化水素類、クロロベンゼン等のハロゲン化芳香 族炭化水素類、アセトン、メチルエチルケトン等のケト ン類、塩化メチレン、クロロホルム、塩化エチレン等の ハロゲン化脂肪族炭化水素類、テトラヒドロフラン、エ チルエーテル等の環状または直鎖状のエーテル類などの 通常の有機溶媒を単独または2種以上混合して用いるこ とができる。塗布方法としては、ブレードコーティング 法、マイヤーバーコーティング法、スプレーコーティン グ法、浸漬コーティング法、ビードコーティング法、エ アーナイフコーティング法、カーテンコーティング法等 の通常のコーティング法を採用することができる。そし て、電荷輸送層 2 の厚みは、一般的には  $5\sim5$   $0~\mu$  m、 好ましくは10~30μmが適当ある。

【0021】本発明の感光層が単層構造からなる場合に おいては、感光層は前記ヒドロキシガリウムフタロシア ニン結晶および電荷輸送材料が結着樹脂に分散された光 導電層よりなる。電荷輸送材料および結着樹脂は感光層 が積層構造からなる場合と同様なものが使用され、前記 と同様の方法に従って光導電層が形成される。

【0022】 導電性支持体3としては、アルミニウム、ニッケル、クロム、ステンレス鋼等の金属類、アルミニウム、チタニウム、ニッケル、クロム、ステンレス、金、バナジウム、酸化スズ、酸化インジウム、ITO等の薄膜を被覆したプラスチックフィルムなどあるいは導電性付与剤を塗布または含浸させた紙、プラスチックフィルムなどがあげられる。これらの導電性支持体3は、ドラム状、シート状、プレート状等、適宜の形状のものとして使用されるが、これらに限定されるものではない。さらに必要に応じて、導電性支持体3の表面は、例えば、表面の酸化処理や薬品処理および着色処理等または砂目立て等の乱反射処理などを施してもよい。

【0023】また、導電性支持体3と感光層の間にさらに下引層4が介在してもよい。この下引層4は、感光層の帯電時において導電性支持体3から感光層への電荷の注入を阻止すると共に、感光層を導電性支持体3に対して一体的に接着保持させる接着層としての作用があり、

場合によっては、。導電性支持体3の光の反射光防止作用 等を示す。上記下引層4を形成する材料としては、ポリ エチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂、メ タクリル樹脂、ポリアミド樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸 ビニル樹脂、フェノール樹脂、ポリカーボネート樹脂、 ポリウレタン樹脂、ポリイミド樹脂、塩化ピニリデン樹 脂、ポリビニルアセタール樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニ ル共重合体、ポリビニルアルコール樹脂、水溶性ポリエ ステル樹脂、ニトロセルロース、カゼイン、ゼラチン、 ポリグルタミン酸、澱粉、スターチアセテート、アミノ 澱粉、ポリアクリル酸樹脂、ポリアクリルアミド樹脂、 ジルコニウムキレート化合物、チタニルキレート化合 物、チタニルアルコキシド化合物等の有機チタニル化合 物、シランカップリング剤などの公知の材料を用いるこ とができる。下引層4を形成するときに採用する塗布方 法としては、ブレードコーティング法、マイヤーパーコ ーティング法、スプレーコーティング法、浸漬コーティ ング法、ビードコーティング法、エアーナイフコーティ ング法、カーテンコーティング法等の通常の方法があげ られる。そして、下引層 4 の厚みは、0 . 0 1  $\sim$  1 0  $\mu$ m、好ましくは $0.\,\,0\,\,5\,\sim\,2\,\mu\,$ mが適当である。

【0024】さらに必要に応じて、感光層の表面に保護 層5を被覆してもよい。この保護層5は、積層構造から なる感光層の帯電時の電荷輸送層2の化学的変質を防止 すると共に、感光層の機械的強度を改善するために被覆 される。上記保護層5は導電性材料を適当な結着樹脂中 に含有させて形成されている。導電性材料としては、ジ メチルフェロセン等のメタロセン化合物、N, N' -ジ フェニルーN,N′ービスー(mートリル)ベンジジン 等の芳香族アミノ化合物、酸化アンチモン、酸化スズ、 酸化チタン、酸化インジウム、酸化スズー酸化アンチモ ン等の金属酸化物などを用いることができるが、これら に限定されるものではない。また、この保護層5の形成 に用いる結着樹脂としては、ポリアミド樹脂、ポリウレ タン樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリケト ン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルケトン樹 脂、ポリスチレン樹脂、ポリアクリルアミド樹脂等の公 知の樹脂を用いることができる。上記保護層5はその電 気抵抗が $10^9 \sim 10^{14} \Omega \cdot cm$ となるように構成する ことが好ましい。電気抵抗が10<sup>14</sup>Q・cmより高くな ると残留電位が上昇しカブリの多い複写物となってしま い、一方、10°Q·cmより低くなると画像のボケ、 解像力の低下が生じてしまう。また、保護層 5 は像露光 に照射される光の透過を実質上妨げないように構成され なければならない。保護層5を形成するときに採用する **塗布方法としては、ブレードコーティング法、マイヤー** バーコーティング法、スプレーコーティング法、浸漬コ ーティング法、ビードコーティング法、エアーナイフコ ーティング法、カーテンコーティング法等の通常の方法 があげられる。そして、保護層5の厚みは、0.5~2

 $0 \mu m$ 、好ましくは $1 \sim 10 \mu m$ が適当である。

[0025]

【実施例】以下、実施例によって本発明を具体的に説明 する。なお、実施例および比較例において、「部」は重 量部を意味する。

合成例 (ヒドロキシガリウムフタロシアニンの合成) 1,3-ジイミノイソインドリン30部および三塩化ガリウム9.1部をキノリン230部中に添加し、200 ℃において3時間反応させた後、生成物を濾別した。次 いで、アセトン、メタノールで洗浄し、湿ケーキを乾燥してクロロガリウムフタロシアニン結晶28部を得た。得られたクロロガリウムフタロシアニン結晶3部を濃硫酸60部に0℃にて溶解後、この溶液を5℃の蒸留水450部中に滴下して結晶を析出させた。蒸留水、希アンモニア水等で洗浄後、乾燥してヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶2.5部を得た。元素分析値(%)は下記の表1に示すとおりである。

#### 【表1】

## ヒドロキシガリウムフタロシアニンの分子式

C12 H17 Ns OG a

元素分析	С	Н	N	C 1
計算値	64.14	2. 86	18.70	
実測値	62.06	2. 67	17.62	0.46

上記のようにして得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の粉末X線回折図を図5に、IRスペクトルを図6にそれぞれ示す。

#### 【0026】実施例1

合成例で得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶3部をジメチルホルムアミド50部に添加し、100 ℃にて28時間撹拌した後、結晶を分離した。次いで、 メタノールで洗浄し、乾燥した後、自動乳鉢で5時間ミ リングしてヒドロキシガリウムフタロシアニン2.7部 を得た。得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶1部をジメチルホルムアミド15部および直径1mmのガラスビーズ30部と共に24時間ミリングした後、結晶を分離した。次いで、酢酸nーブチルで洗浄後、乾燥してヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶0.9部を得た。元素分析値(%)は下記の表2に示すとおりである。

#### 【表2】

元素分析	С	Н	N	C 1
計算値	64.14	2. 86	18.70	
実測値	63.37	2. 58	18.15	0.31

上記のようにして得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の粉末X線回折図を図7に、IRスペクトルを図8にそれぞれ示す。

### 【0027】実施例2

合成例で得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶3部を濃硫酸80部に0℃にて溶解後、この溶液を5℃の蒸留水450部中に滴下して結晶を析出させた。蒸留水、希アンモニア水等で洗浄後、乾燥してヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶2.6部を得た。この結晶1.5部をジメチルホルムアミド25部に添加し、100℃にて28時間撹拌した後、結晶を分離した。次いで、メタノールで洗浄し、乾燥した後、自動乳鉢で5時間ミリングしてヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶1部をジメチルホルムアミド15部および直径1mmのガラスビーズ30部と共にミリングした後、結晶

を分離した。次いで、酢酸n-ブチルで洗浄後、乾燥してヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶0.9部を得た。その粉末X線回折図を図9に示す。なお、1Rスペクトルは図8と同じであった。

#### 【0028】実施例3

ジルコニウム化合物(オルガチックス2C540:マツモト製薬社製)10部およびシラン化合物(A1110:日本ユンカー社製)1部とiープロパノール40部およびブタノール20部からなる溶液を浸漬コーティング法でアルミニウム基板上に塗布し、160℃において10分間加熱乾燥して膜厚0.1μmの下引層4を形成した。次いで、実施例1で得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶1部を、ポリビニルブチラール樹脂(エスレックBM-S:積水化学社製)1部および酢酸 nープチル100部と混合し、ガラスビーズと共にペイントシェーカーで1時間処理して樹脂溶液中に分散させ

た。得られた塗布液を浸漬コーティング法で上記下引層 4上に塗布し、100 Cにおいて10 分間加熱乾燥して 膜厚0.15  $\mu$  mの電荷発生層1 を形成した。なお、分 散後の前記ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の結 晶型はX線回折によって分散前の結晶型と比較して変化 していないことを確認した。

【0029】次に、構造式 (1) 【化1】

で示されるN, N' ージフェニル N, N' ービスー (m-トリル) ベンジジン2部と下記構造式 (2)

$$-\leftarrow 0 - \bigcirc C - \bigcirc C - \bigcirc C \rightarrow D$$

$$(2)$$

# Mw=39000 (粘度平均分子量)

で示されるポリ [1, 1-ジ-(p-フェニレン) シクロヘキサンカーボネート] 3部をクロロベンゼン20部に溶解し、得られた塗布液を電荷発生層1が形成されたアルミニウム基板上に浸漬コーティング法で塗布し、120 Cにおいて1 時間加熱乾燥して膜厚 $20\mu$  mの電荷輸送層2を形成した。

【0030】このようにして作製された電子写真感光体の電子写真特性を下記のようにして測定した。静電複写紙試験装置(川口電機製:エレクトロスタティックアナライザーE PA -8100)を用いて、常温常湿(20  $\mathbb C$ 、40% RH)の環境下に-6 K V のコロナ放電により感光体を帯電させた後、タングステンランプの光を、モノクロメーターを用いて800 n mの単色光に分光し、感光体表面上で $1\mu$  W  $/ \mathrm{cm}^2$  になるように調節し、照射した。そして、その初期表面電位  $V_0$  (ボルト)、半減露光量 $E_{1/2}$  (e r g  $/ \mathrm{cm}^2$ ) を測定し、その後 101 u x の白色光を感光体表面上に 1 秒間、射し、残留電位  $V_{RP}$  (ボルト)を測定した。さらに、上記の帯電、露光を1000 回繰り返した後の  $V_0$ 、 $E_{1/2}$ 、 $V_{RP}$ を測定し、その変動量を $\Delta$   $V_0$  、 $\Delta$   $E_{1/2}$ 、 $\Delta$   $V_{RP}$ で表わした。それらの結果を表 20

### 【0031】実施例4

実施例1で得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の代わりに実施例2で得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶を用いた以外は、実施例3と同様の感光体を作製し、同様の測定を行った。その結果を表3に示す。

### 【0032】比較合成例

合成例で得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶1部をジメチルホルムアミド15部および直径1mmのガラスビーズ30部と共に24時間ミリングした後、結晶を分離した。次いで、酢酸nーブチルで洗浄後、乾燥してヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶0.9部を得た。その粉末X線回折図を図10に示す。なお、IRスペクトルは図8と同じであった。

### 【0033】比較例

実施例1で得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の代わりに比較合成例で得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶を用いた以外は、実施例3と同様の感光体を作製し、同様の測定を行った。その結果を表3に示す。

[0034]

【表3】

電荷発生層     初期 特性     性性       使用する     V <sub>0</sub> E <sub>1/2</sub> V <sub>RP</sub> V <sub>0</sub> E <sub>1/2</sub> V <sub>1</sub> 実施例     (V)     (erg/cm <sup>2</sup> )     (V)     (V)     (erg/cm <sup>2</sup> )     (V)       実施例     1     -816     1.8     -20     -805     1.9     -2       実施例     2     -821     1.8     -18     -18     -19     -2       比較合成例     (N     9)     -815     2.2     -21     -803     2.5     -2       比較     (N     9)     -815     2.2     -21     -803     2.5     -2				1	1	1	# # C100	(190	本字件	八八八	耐久性
世間する V <sub>0</sub> E <sub>1/2</sub> V <sub>RP</sub> V <sub>0</sub> E <sub>1/2</sub> 株晶 (V) (erg/cm <sup>2</sup> ) (V) (v) (erg/cm <sup>2</sup> ) 実施例 1 -816 1.8 -20 -805 1.9 (図 7) -821 1.8 -18 -813 1.9 (図 9) -821 2.2 -21 -803 2.5 (図 10) -815 2.2 -21 -803 2.5		電荷発牛層	E E	世界	回こ	E	1 1 100	, 112	1		
技術所     1     1     2       実施所     1     -816     1     8     -20     -805     1     9       実施所     2     -821     1     8     -1     8     -1     9       (図     9     9     -821     1     8     -1     8     -1     9       (図     9     -815     2     2     -21     -803     2     5       (図     10     -815     2     2     -21     -803     2     5		体田する	N.	쩐	V PO	V	E1/2	V RP	$\Delta E_{1/2}$	$\Delta V_0$	$\Delta V_{RP}$
実施例 1 -816 1.8 -20 -805 1.9 (図 7) (図 7) -821 1.8 -18 -813 1.9 (図 9) (図 9) -821 2.2 -21 -803 2.5 (図 10)		4	3 5	1/2 (erg/cm2)	5		(erg/cm²)		(erg	3	3
契施例 1     -816     1.8     -20     -805     1.9       契施例 2     -821     1.8     -18     -813     1.9       以数 9 (図 1)     -815     2.2     -21     -803     2.5				,							•
(図	<b>分析室</b> 3	火箱灰 1	-816	1.8	-20	-865	1.9	-25	0. 1	11	2
実施例 2 -821 1.8 -18 -813 1.9 (図 9) Http://dia.com/dia.	-	-1							,	,	,
比較合成的	安据原 4		-821	1.8	118	-813	1.9	-24	0. 1	×	٥
比較合成例		(K)								,	ı
(018)	工事文章	比較合成例	-815		-21	-88 		-26	0. 3	1 2	ဂ
	100 X	(MI 0)									

### [0035]

【発明の効果】本発明の製造方法により得られるヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶は新規な結晶型を有するものであって、この新規なヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶は、感度が高く、耐久性が良好であり、しかも、安定性に優れている。したがって、上記表3から明らかなように、本発明の製造方法により得られる新規な結晶を用いて、優れた電子写真特性を有する電子写真感光体を作製することができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明にかかる電子写真感光体の模式的断面 図を示す。

【図2】 本発明にかかる電子写真感光体の別の模式的 断面図を示す。 【図3】 本発明にかかる電子写真感光体の他の模式的 断面図を示す。

【図4】 本発明にかかる電子写真感光体のさらに他の 模式的断面図を示す。

【図5】 合成例で得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の粉末X線回折図を示す。

【図6】 合成例で得られたヒドロキシガリウムフタロ シアニン結晶のIRスペクトルを示す。

【図7】 実施例1で得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の粉末X線回折図を示す。

【図8】 実施例1で得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶のIRスペクトルを示す。

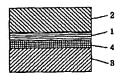
【図9】 実施例2で得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の粉末X線回折図を示す。

【図10】 比較合成例で得られたヒドロキシガリウム フタロシアニン結晶の粉末X線回折図を示す。 【符号の説明】 1····電荷発生層、2····電荷輸送層、3····導電性支持体、4····下引層、5····保護層。

【図1】

-2 -1 -3 【図2】

【図3】



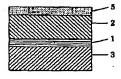
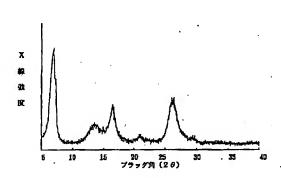
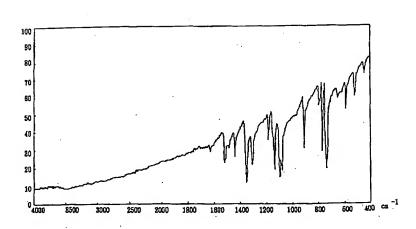


図4】

- 5 - 2 - 1 - 4 - 3 【図5】

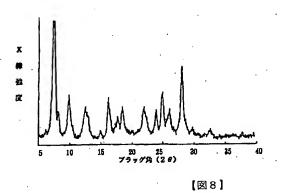


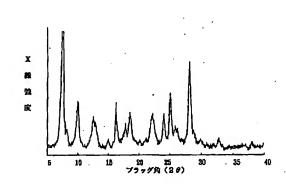
【図6】

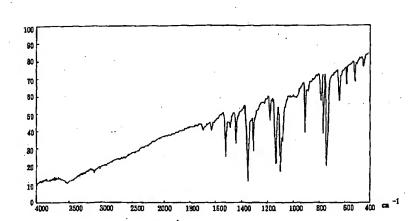




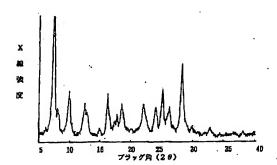








## 【図10】



# フロントページの続き

(72)発明者 飯島 正和 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ ックス株式会社竹松事業所内 (72)発明者 石井 徹 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ ックス株式会社竹松事業所内